

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

支持基板と、前記支持基板上に第一電極と有機発光層と第二電極とを少なくとも積層形成してなる発光表示部と、前記支持基板上に前記発光表示部を気密的に覆うように配設される封止部材と、前記支持基板上に前記封止部材と並んで実装され前記第一、第二電極間に駆動電流を印加するドライバーＩＣと、を備えてなる有機ＥＬパネルであって、

前記封止部材の前記発光表示部と対向する面と反対側の面上に配設され、前記封止部材と重なる基部と前記基部から延設され前記ドライバーＩＣと対向する延設部とを有する放熱部材と、

前記ドライバーＩＣと前記延設部との間に配設され、前記ドライバーＩＣ側が冷却面であり前記延設部側が放熱面である電子冷却素子と、を備えてなることを特徴とする有機ＥＬパネル。

10

【請求項 2】

前記電子冷却素子は、熱伝導部を介して前記ドライバーＩＣ及び／あるいは前記延設部と接続されてなることを特徴とする請求項 1 に記載の有機ＥＬパネル。

【請求項 3】

前記放熱部材と接続されるように設けられ、前記放熱部材の熱を外部に輸送可能な熱輸送部材を備えてなることを特徴とする請求項 1 に記載の有機ＥＬパネル。

【請求項 4】

前記電子冷却素子を制御する駆動回路を備え、前記駆動回路は周囲温度に応じて前記電子冷却素子に出力する電流値を変更することを特徴とする請求項 1 に記載の有機ＥＬパネル。

20

【請求項 5】

前記電子冷却素子は、その面積が前記ドライバーＩＣの面積よりも大きいことを特徴とする請求項 1 に記載の有機ＥＬパネル。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、有機ＥＬ（Electro Luminescence）パネルに関し、特に支持基板上にドライバーＩＣを実装したＣＯＧ（Chip On Glass）型の有機ＥＬパネルに関するものである。

30

【背景技術】**【0002】**

従来、有機ＥＬパネルとして、例えば、少なくとも有機発光層を有する有機層をＩＴＯ（Indium Tin Oxide）等からなる陽極ライン（第一電極ライン）と、アルミニウム（Al）等からなる陰極ライン（第二電極ライン）とで挟持してなる有機ＥＬ素子を発光画素としてガラス材料からなる支持基板上に複数形成して発光表示部を構成するものが知られている（例えば特許文献 1 参照）。かかる有機ＥＬ素子は、前記陽極から正孔を注入し、また、前記陰極から電子を注入して正孔及び電子が前記発光層にて再結合することによって光を発するものである。

40

【0003】

また、前記有機ＥＬ素子を駆動させるためのドライバーＩＣの実装方法としては、このドライバーＩＣを支持基板上に直接実装するＣＯＧ形態が知られている（例えば特許文献 2 参照）。ＣＯＧ型の有機ＥＬパネルは、ＦＰＣ（Flexible Printed Circuit）上にドライバーＩＣを実装するＴＣＰ（Tape Career Package）型等の他の実装方法に対して小型化が可能な点などで優れている。

【先行技術文献】**【特許文献】****【0004】**

【特許文献 1】特開平 8 - 3 1 5 9 8 1 号公報

50

【特許文献2】特開2000-40585号公報

【特許文献3】特開2011-192942号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

C O G型の有機E Lパネルは、支持基板上に形成される金属配線（厚さ0.5 μm程度）上に直接ドライバーICを搭載する構成であるため、熱抵抗が非常に大きくなりドライバーICからの放熱が妨げられドライバーICの温度が高くなりやすい。そのため、特に計器等の車載用機器に用いられ高輝度発光を要求される有機E Lパネルにおいては、ドライバーICからの熱でドライバーICに近い発光画素の劣化や円偏光板の劣化が早く進行する、あるいはドライバーICの温度が定格温度を超える場合が生じ、特に高温時における動作信頼性が低下する可能性があるという問題点がある。

10

【0006】

これに対し、ドライバーICの放熱効率を向上させる方法として、特許文献3には、支持基板のドライバーICが実装される面と反対側の面上にドライバーICと対向しドライバーICから発せられる熱を支持基板の面方向に拡散させる放熱部材を配設する技術が開示されている。

【0007】

しかしながら、特許文献3に開示される技術は、支持基板側から光を出射するボトムエミッション型の有機E Lパネルにおいては放熱部材の大きさが非発光領域に限られ、放熱効率を向上させる点ではなお改良の余地があった。

20

【0008】

そこで本発明は、前述の問題点に鑑み、C O G型の有機E Lパネルにおいて、ドライバーICの放熱効率を向上させることが可能な有機E Lパネルを提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

【0009】

本発明は、前記課題を解決するため、支持基板と、前記支持基板上に第一電極と有機発光層と第二電極とを少なくとも積層形成してなる発光表示部と、前記支持基板上に前記発光表示部を気密的に覆うように配設される封止部材と、前記支持基板上に前記封止部材と並んで実装され前記第一、第二電極間に駆動電流を印加するドライバーICと、を備えてなる有機E Lパネルであって、前記封止部材の前記発光表示部と対向する面と反対側の面上に配設され、前記封止部材と重なる基部と前記基部から延設され前記ドライバーICと対向する延設部とを有する第一の放熱部材と、前記ドライバーICと前記延設部との間に配設され、前記ドライバーIC側が冷却面である前記延設部側が放熱面である電子冷却素子と、を備えてなることを特徴とする。

30

【発明の効果】

【0010】

以上、本発明によれば、C O G型の有機E Lパネルにおいて、ドライバーICの放熱効率を向上させることが可能となる。

40

【図面の簡単な説明】

【0011】

【図1】本発明の実施形態である有機E Lパネルを示す（a）上面図、（b）底面図である。

【図2】同上有機E Lパネルを示す側面図である。

【図3】同上有機E Lパネルを示す上面図である。

【図4】同上有機E Lパネルの要部拡大図である。

【図5】同上有機E Lパネルの有機E L素子を示す断面図である。

【図6】同上有機E Lパネルに備えられるペルチェ素子の駆動回路を示す図である。

50

【発明を実施するための形態】**【0012】**

以下、本発明の実施形態である有機ELパネル100を添付図面に基づき説明する。図1～図3は有機ELパネル100の全体図である。

有機ELパネル100は、図1及び図2に示すように、支持基板11と、発光表示部12と、封止部材13と、ドライバーIC14と、第一の放熱部材15と、ペルチェ素子（電子冷却素子）16と、熱伝導部17と、円偏光板18と、第二の放熱部材19と、を備える。なお、図2においては熱伝導部17は断面を示している。図3は、有機ELパネル100の上面図であって、封止部材13、第一の放熱部材15、ペルチェ素子16、熱伝導部17を省略して図示したものである。なお、図3中においては、後述する各配線の一部を省略して図示している。

10

【0013】

支持基板11は、長方形形状の透明ガラス材からなる電気絶縁性の基板である。支持基板11の一方の面（図2における上面）上には、図1（a）及び図2に示すように、発光表示部12とドライバーIC14とが設けられている。また、支持基板11の一方の面上には、発光表示部12を気密的に覆うように封止部材13が配設され、封止部材13の発光表示部12と対向する面と反対側の面（図2における上面）上には第一の放熱部材15が配設されている。また、ドライバーIC14と第一の放熱部材15の後述する延設部15bとの間にはペルチェ素子16が配設されている。また、支持基板11の一方の面上には、図3に示すように、後述する発光表示部12の各陽極ラインと接続される陽極配線21と後述する発光表示部12の各陰極ラインと接続される陰極配線22とドライバーIC14を外部回路と電氣的に接続するための入力配線23とが形成されている。

20

これに対し、支持基板11の他方の面（ドライバーIC14が実装される面と反対側の面であって、図2における底面）上には、図1（b）及び図2に示すように、円偏光板18と第二の放熱部材19とが並んで設けられている。

【0014】

図4及び図5は有機ELパネル100の要部拡大図である。なお、図4においては封止部材13及び第一の放熱部材15を省略して図示している。

発光表示部12は、図4及び図5に示すように、複数形成される陽極ライン（第一電極）12aと、絶縁膜12bと、隔壁12cと、有機層12dと、複数形成される陰極ライン（第二電極）12eと、から主に構成され、各陽極ライン12aと各陰極ライン12eとが交差して有機層12dを挟持する個所からなる複数の発光画素（有機EL素子）を備えるいわゆるパッシブマトリクス型の発光表示部である。本実施形態は、支持基板11側から発光表示部12の表示光を出射するいわゆるボトムエミッション型の有機ELパネルとなる。また、発光表示部12は、図2及び図5に示すように、封止部材13によって気密的に覆われている。

30

【0015】

陽極ライン12aは、ITO等の透光性の導電材料からなる。陽極ライン12aは、蒸着法やスパッタリング法等の手段によって支持基板11上に前記導電材料を層状に形成した後、フォトリソグラフィー法等によって互いに略平行となるように形成される。各陽極ライン12aは、端部の一方側（図1における下方側）で各陽極配線21と接続される。

40

【0016】

絶縁膜12bは、例えばポリイミド系の電気絶縁性材料から構成され、陽極ライン12aと陰極ライン12eとの間に位置するように形成され、両電極ライン12a、12eの短絡を防止するものである。絶縁膜12bには、各発光画素を画定するとともに輪郭を明確にする開口部12b1が形成されている。また、絶縁膜12bは、陰極配線22と陰極ライン12eとの間にも延設されており、各陰極配線22と各陰極ライン12eとを接続させるコンタクトホール12b2を有する。

【0017】

隔壁12cは、例えばフェノール系の電気絶縁性材料からなり、絶縁膜12b上に形成

50

される。隔壁 12 c は、その断面が絶縁膜 12 b に対して逆テーパ形状となるようにフォトリソグラフィ法等の手段によって形成されるものである。また、隔壁 12 c は、陽極ライン 12 a と直交する方向に等間隔に複数形成される。隔壁 12 c は、その上方から蒸着法やスパッタリング法等によって有機層 12 d 及び陰極ライン 12 e を形成する場合に有機層 12 d 及び陰極ライン 12 e が分断される構造を得るものである。

【0018】

有機層 12 d は、陽極ライン 12 a 上に形成されるものであり、少なくとも有機発光層を含むものである。なお、本実施形態においては、有機層 12 d は正孔注入層、正孔輸送層、有機発光層、電子輸送層及び電子注入層を蒸着法やスパッタリング法等の手段によって順次積層形成してなるものである。

10

【0019】

陰極ライン 12 e は、アルミニウム (Al) やマグネシウム銀 (Mg:Ag) 等の陽極ライン 12 a よりも導電率が高い金属性導電材料を蒸着法等の手段により陽極ライン 12 a と交差するように複数形成してなるものである。また、各陰極ライン 12 e は、絶縁膜 12 b に設けられるコンタクトホール 12 b2 を介して各陰極配線 22 と接続される。

【0020】

封止部材 13 は、例えば凹状に成型されたガラス材料からなり、接着剤 13 a を介して支持基板 11 上に配設され発光表示部 12 を気密的に収納するものである。なお、封止部材 13 は、平板状であってもよい。

【0021】

ドライバー IC 14 は、発光表示部 12 を発光駆動させる駆動回路を構成し、信号線駆動回路及び走査線駆動回路等を備えるものである。ドライバー IC 14 は、公知の COG 実装技術によって支持基板 11 上に発光表示部 12 に応じて封止部材 13 と並んで実装され、各陽極配線 21 及び各陰極配線 22 を介して各陽極ライン 12 a 及び各陰極ライン 12 e と電氣的に接続され、外部回路からの駆動信号に基づいて各陽極ライン 12 a と各陰極ライン 12 e との間に駆動電流を印加する。

20

【0022】

第一の放熱部材 15 は、銅 (Cu) やアルミニウム (Al) 等の、支持基板 11 の材料よりも熱伝導率の良い材料を平板状に加工してなり、封止部材 13 の発光表示部 12 と対向する面と反対側の面上に図示しない接着剤等を介して配設されるものである。第一の放熱部材 15 は、封止部材 13 のパネル面方向に広く配置されるものであり、その面積は少なくとも封止部材 13 の面積よりも大きく、封止部材 13 と重なる基部 15 a と、ドライバー IC 14 と間隔をあけて対向するように基部 15 a から支持基板 11 と平行方向に突出する延設部 15 b とを有する。また、第一の放熱部材 15 の厚さは、有機 EL パネル 100 の用途やドライバー IC 14 の発熱量に応じて適宜設定されるものであるが、有機 EL パネル 100 としての総厚を抑制する観点からは極力薄く形成されることが望ましい。また、延設部 15 b には、第一の放熱部材 15 の面方向と平行に内部を貫通する貫通孔 15 c が形成され、この貫通孔 15 c にヒートパイプ (熱輸送部材) 15 d が挿通されてヒートパイプ 15 d と第一の放熱部材 15 (延設部 15 b) とが接続されている。ヒートパイプ 15 d は、例えば第一の放熱部材 15 と同様の熱伝導率の良い材料を厚さ約 1 mm のバー状に形成してなり、延設部 15 b から突出する側の端部が外部の放熱器 (図示しない) と接続されて第一の放熱部材 15 内の熱を外部に輸送するものである。なお、貫通孔 15 c 内に後述する熱伝導部 17 と同様の熱伝導材料や熱伝導性のグリスを充填し、延設部 15 b とヒートパイプ 15 d とを熱伝導材料等を介して接続して延設部 15 b とヒートパイプ 15 d との密着性を向上させてもよい。

30

40

【0023】

ペルチェ素子 16 は、直流電流を印加することで一方の面 (冷却面) で吸熱し、他方の面 (放熱面) で放熱する電子冷却素子であり、ドライバー IC 14 と延設部 15 b との間に配設される。なお、ペルチェ素子 16 は、ドライバー IC 14 側の面 (図 2 における底面) が冷却面となり、延設部 15 b 側の面 (図 2 における上面) が放熱面となるように配

50

置される。また、ペルチェ素子 16 の冷却面とドライバー IC 14 との間及びペルチェ素子 16 の放熱面と延設部 15 b との間には熱伝導部 17 が設けられており、ペルチェ素子 16 の冷却面は熱伝導部 17 を介してドライバー IC 14 と接続され、また、ペルチェ素子 16 の放熱面は熱伝導部 17 を介して延設部 15 b と接続される。なお、ペルチェ素子 16 はドライバー IC 14 及び / あるいは延設部 15 b と直に接するものであってもよい。

【0024】

ペルチェ素子 16 は、定電流駆動を行う駆動回路 30 と接続されており、駆動回路 30 から直流電流が印加される。図 6 は駆動回路 30 の一例を示すものである。駆動回路 30 は、シンク型（電流引き込み型）の定電流回路であって、直流電源 31 と、FET（Field Effect Transistor）32 と、オペアンプ 33 と、NTCサーミスタ 34 と、抵抗 R1 及び R2 と、を備える。駆動回路 30 において、ペルチェ素子 16 は、一方の端子が直流電源 31 と接続され、他方の端子が FET 32 のドレイン側と接続されている。FET 32 は、ゲート側がオペアンプ 33 の出力側と接続され、ソース側がオペアンプ 33 のマイナス端子と抵抗 R1 との間の点 35 に接続される。オペアンプ 33 はプラス端子が他の電源 36 に接続され、マイナス端子が抵抗 R1 に接続される。抵抗 R2 は一端が抵抗 R1 と直列接続され、他端が接地される。NTCサーミスタ 34 は抵抗 R1 と並列接続される。かかる駆動回路 30 は、点 35 の電位を V_1 とし、抵抗 R1, R2 及び NTCサーミスタ 34 の合成抵抗を R とし、直流電源 31 からペルチェ素子 16 及び FET 32 に流れる電流を I とするとき、

$$V_1 = I R$$

という関係が成り立つ。

さらに、オペアンプ 33 は、マイナス端子側の電位 V_1 がプラス端子側の電位 V_{ref} となるように（ $V_1 = V_{ref}$ ）動作し、電位 V_1 は常に一定（ V_{ref} ）となる。

そして、電流 I は、

$$I = V_1 / R$$

という関係が成り立つため、合成抵抗 R が一定であれば一定電流となる。

【0025】

また、駆動回路 30 は、周囲温度（環境温度）が高くなると NTCサーミスタ 34 の抵抗値が下がって合成抵抗 R が下がり、ペルチェ素子 16 に出力する電流 I が上昇して吸熱効果を高め、周囲温度が低くなると NTCサーミスタ 34 の抵抗値が上がって合成抵抗 R が上がり、ペルチェ素子 16 に出力する電流 I が低下して吸熱効果を弱める。これにより、駆動回路 30 はペルチェ素子 16 の吸熱性能の温度補償を行うことができる。なお、駆動回路 30 は上述の例に限定されるものではなく、FET 32 に替えてトランジスタを用いた構成であってもよく、ソース型（電流吐き出し型）の駆動回路であってもよい。

【0026】

熱伝導部 17 は、シリコン系樹脂材料やアクリル系樹脂材料等からなる、支持基板 11 の材料よりも熱伝導率が高く、特に厚さ方向の熱伝導率に優れた粘着性のある材料をドライバー IC 14 とペルチェ素子 16 の冷却面との隙間及びペルチェ素子 16 の放熱面と第一の放熱部材 15 の延設部 15 b との隙間を満たすように充填してなる。これにより、ペルチェ素子 16 とドライバー IC 14 あるいは第一の放熱部材 15 との密着性を高めてドライバー IC 14 からの吸熱性能及び / あるいは第一の放熱部材 15 への放熱性能を向上させることができる。なお、熱伝導部 17 は、前述の材料を柔軟性のあるシート状に加工したものであってもよい。この場合はドライバー IC 14 とペルチェ素子 16 との間及びペルチェ素子 16 と延設部 15 b との間にそれぞれシート状の熱伝導部 17 が配置される。

【0027】

また、ペルチェ素子 16 及び熱伝導部 17 は、支持基板 11 の非発光領域を覆うようにパネル面方向に広く配置されるものであり、その面積は少なくともドライバー IC 14 の面積よりも大きいことが望ましい。具体的には、ペルチェ素子 16 及び熱伝導部 17 は、

その面積が少なくともドライバーＩＣ１４よりも大きく、ドライバーＩＣ１４とともに支持基板１１の一方の面のドライバーＩＣ１４が実装されない領域も覆うように配設される。ペルチェ素子１６は、支持基板１１の一方の面のドライバーＩＣ１４が実装されない領域において、冷却面が熱伝導部１７を介して支持基板１１と接続され、支持基板１１からの熱の伝達が可能となっている。また、ペルチェ素子１６は、放熱面全体が第一の放熱部材１５の延設部１５ｂと接し、放熱面全体から第一の放熱部材１５への熱の伝達が可能となっている。

【００２８】

円偏光板１８は、直線偏光板と複屈折板を積層してなる板状の光透過性部材であり、外光の反射を抑制するものである。円偏光板１８は、図示しない粘着層を介して支持基板１１の出射面側に貼り付けられる。

10

【００２９】

第二の放熱部材１９は、銅（Ｃｕ）やアルミニウム（Ａｌ）あるいはグラファイト等の、支持基板１１の材料よりも熱伝導率が高く、面方向の熱伝導率が熱伝導部１７よりも優れた材料を加工した粘着性シートからなり、支持基板１１のドライバーＩＣ１４が実装される面と反対側の面上にドライバーＩＣ１４と対向するように配設されるものである。特に面方向の熱伝導率が優れたグラファイトが望ましい。本実施形態においては第二の放熱部材１９は支持基板１１の出射面側に貼り付けられることとなる。なお、後述するようにドライバーＩＣ１４からの発熱をパネル面方向に拡散するべく、第二の放熱部材１９は有機ＥＬパネル１００がケースに収納される等してモジュール化された場合に支持基板１１以外にはいずれの部材とも接触しないものとする。第二の放熱部材１９は、支持基板１１の非発光領域を覆うようにパネル面方向に広く配置されるものであり、その面積は少なくともドライバーＩＣ１４の面積よりも大きいことが望ましい。また、第二の放熱部材１９の厚さは、有機ＥＬパネル１００の用途やドライバーＩＣ１４の発熱量に応じて適宜設定されるものであるが、支持基板１１の同一面上に配置される円偏光板１８よりも薄くすることで、有機ＥＬパネル１００としての総厚を抑制することができ好適である。

20

【００３０】

陽極配線２１は、陽極ライン１２ａとドライバーＩＣ１４と接続する配線であり、例えば陽極ライン１２ａと同材料であるＩＴＯ、クロム（Ｃｒ）あるいはアルミニウム（Ａｌ）等の導電材料またはこれら導電材料の積層体からなる。陽極配線２１は、支持基板１１の一方の面上に陽極ライン１２ａと一体的に形成される、あるいは陽極ライン１２ａと接続されるように別体に形成される。

30

【００３１】

陰極配線２２は、陰極ライン１２ｅとドライバーＩＣ１４と接続する配線であり、例えば陽極ライン１２ａと同材料であるＩＴＯ、クロム（Ｃｒ）あるいはアルミニウム（Ａｌ）等の導電材料またはこれら導電材料の積層体からなる。陰極配線２２は、支持基板１１の一方の面上の側方に各陰極ライン１２ｅに対して左右交互に引き回し形成される配線であり、一端が陰極ライン１２ｅと接続され他端がドライバーＩＣ１４と接続される。陰極配線２２は、図４に示すように、コンタクトホール１２ｂ２を介して陰極ライン１２ｅと接続可能とするべく少なくとも陰極ライン１２ｅとの接続個所となる端部が絶縁膜１２ｂを介して陰極ライン１２ｅの下方に位置するように形成される。

40

【００３２】

入力配線２３は、ドライバーＩＣ１４と外部回路とを電氣的に接続するための配線であり、例えば陽極ライン１２ａと同材料であるＩＴＯ、クロム（Ｃｒ）あるいはアルミニウム（Ａｌ）等の導電材料またはこれら導電材料の積層体からなる。入力配線２３は、支持基板１１の一方の面上のドライバーＩＣ１４近傍に引き回し形成され、一端がドライバーＩＣ１４と接続され他端がＡＣＦ（図示しない）を介してＦＰＣ（図示しない）と接続される。

【００３３】

以上の各部によって有機ＥＬパネル１００が構成されている。

50

【 0 0 3 4 】

次に、本実施形態における主要な放熱経路について説明する。図 2 中の矢印で示すように、ドライバー IC 14 から発せられた熱は、第一の放熱経路として、まず熱伝導部 17 を介してペルチェ素子 16 の冷却面に吸熱され、その後ペルチェ素子 16 の放熱面から熱伝導部 17 を介して第一の放熱部材 15 の延設部 15 b に伝達される。延設部 15 b に伝達された熱は、一部が第一の放熱部材 15 全体に拡散し第一の放熱部材 15 から外部に放射され、一部がヒートパイプ 15 d によって外部の前記放熱器に輸送される。また、ドライバー IC 14 から発せられた熱の一部は、第二の放熱経路として、まず支持基板 11 内に伝わりその後第二の放熱部材 19 に伝達される。第二の放熱部材 19 に伝達された熱は第二の放熱部材 19 全体に拡散される。さらに、第二の放熱部材 19 全体に拡散した熱は、第二の放熱部材 19 自体から外部に放射されるとともに、第二の放熱部材 19 から熱の拡散時点で第二の放熱部材 19 よりも低温である支持基板 11 の第二の放熱部材 19 と接する個所全体に伝達される。さらに、支持基板 11 に移動した熱は熱伝導部 17 を介してペルチェ素子 16 の冷却面に吸熱され、その後ペルチェ素子 16 の放熱面から熱伝導部 17 を介して第一の放熱部材 15 の延設部 15 b に伝達される。延設部 15 b に伝達された熱は、一部が第一の放熱部材 15 全体に拡散し第一の放熱部材 15 から外部に放射され、一部がヒートパイプ 15 d によって外部の前記放熱器に輸送される。

10

すなわち、第一の放熱経路によって、ドライバー IC 14 からの熱をペルチェ素子 16 によって吸熱し、さらに封止部材 13 の面上に配設される面積の広い第一の放熱部材 15 に伝達することができ、効率よく放熱することができる。また、第二の放熱経路によって、面方向の熱伝導率に優れた第二の放熱部材 19 を介してドライバー IC 14 からの熱を支持基板 11 の面方向に拡散することによって、ドライバー IC 14 の発熱によるヒートスポットを緩和させ、また、支持基板 11 を介して良好にペルチェ素子 16 の冷却面全体に熱を伝達することができ、ドライバー IC 14 の放熱効率をさらに向上させることができる。

20

【 0 0 3 5 】

かかる有機 EL パネル 100 は、支持基板 11 と、支持基板 11 上に陽極ライン 12 a と有機発光層を含む有機層 12 d と陰極ライン 12 e とを少なくとも積層形成してなる発光表示部 12 と、支持基板 11 上に発光表示部 12 を気密的に覆うように配設される封止部材 13 と、支持基板 11 上に封止部材 13 と並んで実装され陽極ライン 12 a と陰極ライン 12 e との間に駆動電流を印加するドライバー IC 14 と、を備えてなる有機 EL パネルであって、封止部材 13 の発光表示部 12 と対向する面と反対側の面上に配設され、封止部材 13 と重なる基部 15 a と基部 15 a から延設されドライバー IC 14 と対向する延設部 15 b を有する第一の放熱部材 15 と、ドライバー IC 14 と延設部 15 b との間に配設され、ドライバー IC 14 側が冷却面であり延設部 15 b 側が放熱面であるペルチェ素子 16 と、を備えてなるものである。

30

これにより、封止部材 13 の面上に面積の広い第一の放熱部材 15 を配設し、ドライバー IC 14 からの熱をペルチェ素子 16 によって吸熱して第一の放熱部材 15 に伝達することができ、効率よく放熱することができる。また、ボトムエミッション型の有機 EL パネル 100 において光出射面でない封止部材 13 の面を利用して第一の放熱部材 15 を配設するため、放熱構造が複雑化することがなく有機 EL パネル 100 全体が大型化することを抑制できる。

40

【 0 0 3 6 】

また、ペルチェ素子 16 は、熱伝導部 17 を介してドライバー IC 14 及び / あるいは延設部 15 b と接続されてなる。

これにより、ペルチェ素子 16 とドライバー IC 14 あるいは第一の放熱部材 15 との密着性を高めてドライバー IC 14 からの吸熱性能及び / あるいは第一の放熱部材 15 への放熱性能を向上させることができる。

【 0 0 3 7 】

また、第一の放熱部材 15 と接続されるように設けられ、第一の放熱部材 15 の熱を外

50

部に輸送可能なヒートパイプ 15 d を備えてなる。

これにより、放熱効率を向上させ、ドライバー IC 14 の発熱に対して放熱が追いつかず、ペルチェ素子 16 の放熱面から冷却面に熱が再伝達されることを防止することができる。

【0038】

また、ペルチェ素子 16 を制御する駆動回路 30 を備え、駆動回路 30 は周囲温度に応じてペルチェ素子 16 に出力する電流値を変更する。

これにより、周囲温度が変化する場合であってもドライバー IC 14 を略一定温度で動作させることができる。

【0039】

また、ペルチェ素子 16 は、その面積がドライバー IC 14 の面積よりも大きい。

これにより、ドライバー IC 14 と接する個所以外の個所からも吸熱して第一の放熱部材 15 に伝達することができ、さらに効率よく放熱することができる。

【産業上の利用可能性】

【0040】

本発明は、COG 型の有機 EL パネルに好適である。

【符号の説明】

【0041】

- 100 有機 EL パネル
- 11 支持基板
- 12 発光表示部
- 12 a 陽極ライン（第一電極）
- 12 b 絶縁膜
- 12 c 隔壁
- 12 d 有機層
- 12 e 陰極ライン（第二電極）
- 13 封止部材
- 14 ドライバー IC
- 15 第一の放熱部材
- 15 a 基部
- 15 b 延設部
- 15 c 貫通孔
- 15 d ヒートパイプ（熱輸送部材）
- 16 ペルチェ素子（電子冷却素子）
- 17 熱伝導部
- 18 円偏光板
- 19 第二の放熱部材
- 21 陽極配線
- 22 陰極配線
- 23 入力配線
- 30 駆動回路

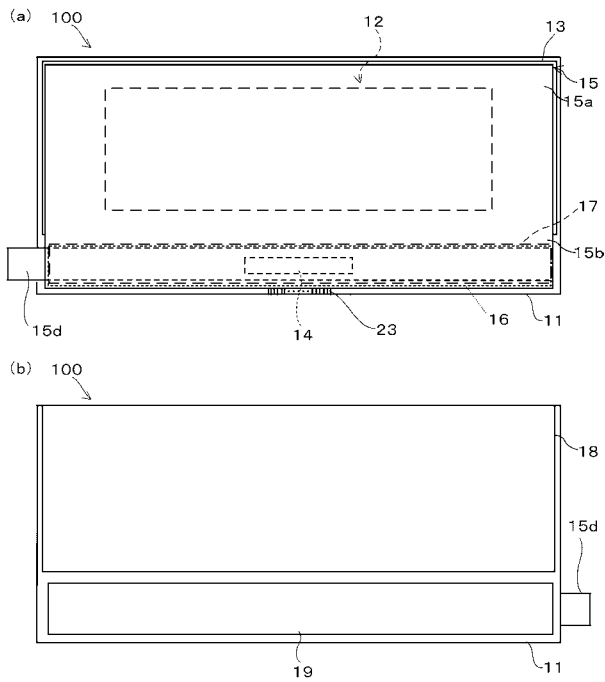
10

20

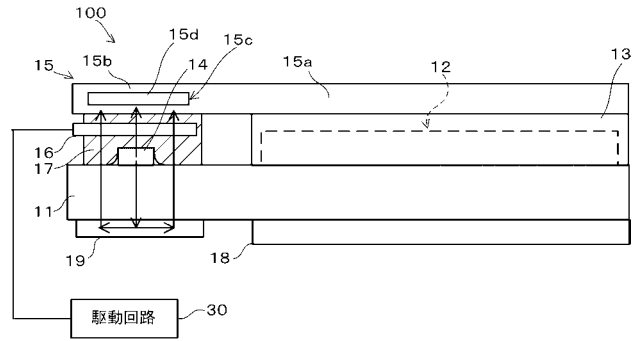
30

40

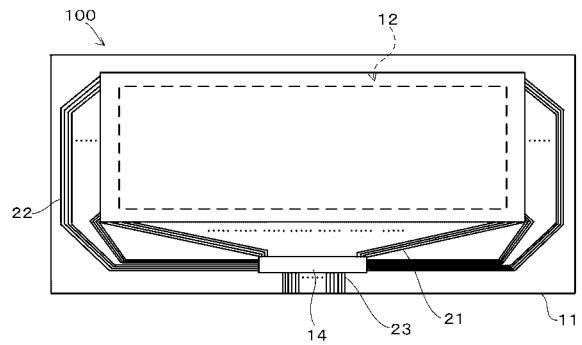
【図 1】



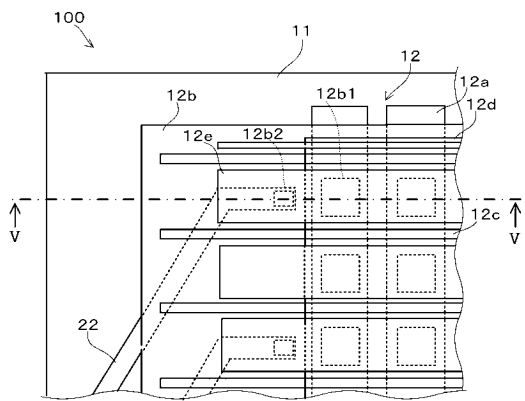
【図 2】



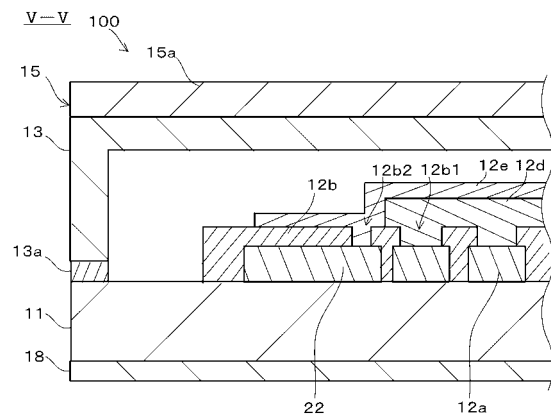
【図 3】



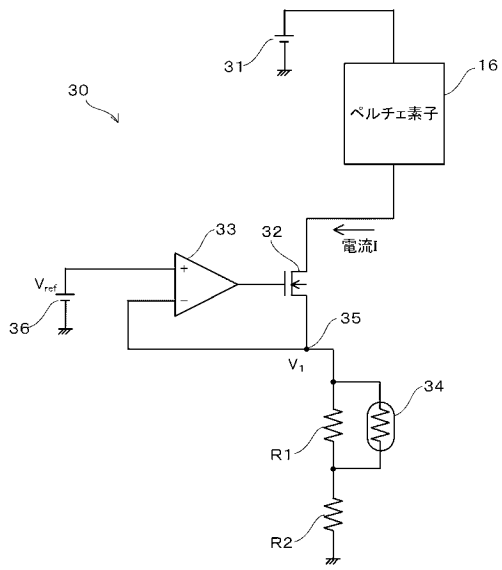
【図 4】



【図 5】



【図 6】



专利名称(译)	有机EL面板		
公开(公告)号	JP2015103686A	公开(公告)日	2015-06-04
申请号	JP2013243619	申请日	2013-11-26
[标]申请(专利权)人(译)	日本精机株式会社		
申请(专利权)人(译)	日本精机株式会社		
[标]发明人	土田正人		
发明人	土田 正人		
IPC分类号	H01L51/50 H05B33/04 H05B33/08		
CPC分类号	Y02B20/32		
FI分类号	H05B33/14.A H05B33/04 H05B33/08		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC21 3K107/CC24 3K107/EE42 3K107/EE62 3K107/FF15 3K107/HH00 3K107/HH04		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种有机EL面板，其能够提高驱动器IC的散热效率。 解决方案：支撑基板11，通过在支撑基板11上至少堆叠第一电极，有机发光层和第二电极而形成的发光显示部分12和支撑基板11上的发光显示部分12是气密的。 驱动器IC 14与密封构件13一起安装在支撑基板11上，用于在第一电极和第二电极之间施加驱动电流。 是有机EL面板100。 设置在密封部件13的与发光显示部12相对的面的相反侧的面上且与密封部件13重叠的基部15a和从基部15a延伸并与驱动器IC 14相对的延伸部15b设置。 它包括第一散热构件15和珀耳帖元件16，该珀耳帖元件16布置在驱动器IC 14和延伸部15b之间，并且具有驱动器IC 14侧作为冷却表面和延伸部15b侧作为散热表面。 [选择图]图2

